

ДП КВАЗАР-ИС

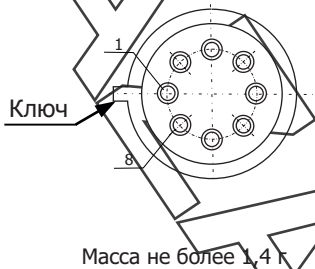
ЭТИКЕТКА

Микросхемы опытной партии
159НТ1А, 159НТ1Б, 159НТ1В

Шифр кода маркировки
159НТ1А - 159НТ1А,
159НТ1Б - 159НТ1Б,
159НТ1В - 159НТ1В

Полупроводниковые интегральные микросхемы 159НТ1А, 159НТ1Б, 159НТ1В предназначены для работы в радиоэлектронной аппаратуре в качестве базовой схемы дифференциального усилителя.

Схема расположения выводов



НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ МИКРОСХЕМЫ

Обозначение вывода	Наименование вывода
2	Коллектор VT1
3	База VT1
4	Эмиттер VT1
6	Эмиттер VT2
7	База VT2
8	Коллектор VT2

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25°C

Наименование параметра, единица измерения	Норма						Примечание
	159НТ1А		159НТ1Б		159НТ1В		
	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	
Статический коэффициент прямой передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме большого сигнала	30	90	60	180	-	-	1
	-	-	-	-	80	-	2
Отношение статических коэффициентов передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме большого сигнала	0,9	-	0,9	-	-	-	1
	-	-	-	-	0,92	-	2
Модуль разности прямых напряжений на переходах эмиттер-база, мВ	-	3	-	3	-	3	1
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($f = 100\text{МГц}$)	2,5	-	2,5	-	2,5	-	-
Примечание							
1 при $I_E = 1\text{мА}$							
2 при $I_E = 0,05\text{мА}$							

Содержание драгоценных металлов в расчете на 1000 шт. микросхем

Содержание золота _____ г

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 159НТ1А, 159НТ1Б, 159НТ1В соответствуют техническим условиям АЕЯР 431410.4Б5ТУ

Приняты по извещению № _____ от _____ дата

Место для
штампа ОТК

Место для штампа
военного
представительства

Место для штампа "Перепроверка произведена _____" дата

Место для
штампа ОТК

Место для штампа
военного
представительства